|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|  |  |  |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1-C5 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 5 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C6 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C7 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C8, C9 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 2 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C10 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C11 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C12 | Чип 0402 X7R - 16 В - 0,01 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX7R8BB103 |
| C13 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C14 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C15 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C16 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C17 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C18 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C19 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C20 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C21-C82 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 62 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C83-C88 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 6 | T491A106K010AT |
| C89-C109 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 21 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C110, C111 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 2 | T491A106K010AT |
| C1-C5 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 5 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C6 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C7 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C8, C9 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 2 | CC0603KRX5R8BB475 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| C10 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C11 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C12 | Чип 0402 X7R - 16 В - 0,01 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX7R8BB103 |
| C13 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C14 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C15 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C16 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C17 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C18 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C19 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C20 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C21-C82 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 62 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C83-C88 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 6 | T491A106K010AT |
| C89-C109 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 21 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C110, C111 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 2 | T491A106K010AT |
| C1-C5 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 5 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C6 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C7 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C8, C9 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 2 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C10 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C11 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C12 | Чип 0402 X7R - 16 В - 0,01 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX7R8BB103 |
| C13 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C14 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C15 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C16 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C17 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C18 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C19 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C20 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| C21-C82 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 62 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C83-C88 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 6 | T491A106K010AT |
| C89-C109 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 21 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C110, C111 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 2 | T491A106K010AT |
| C1-C5 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 5 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C6 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C7 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C8, C9 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 2 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C10 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C11 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C12 | Чип 0402 X7R - 16 В - 0,01 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX7R8BB103 |
| C13 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C14 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C15 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C16 | Чип «B» - 10 B - 100 мкФ , ф. Vishay | 1 | 595D107X9010B2T |
| C17 | Чип «B» - 25 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. Vishay | 1 | 293D106X9025B2TE3 |
| C18 | Чип 0603 X5R - 25 В - 4,7 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0603KRX5R8BB475 |
| C19 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C20 | Чип 0402 X5R - 16 В - 1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 1 | CC0402KRX5R7BB105 |
| C21-C82 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 62 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C83-C88 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 6 | T491A106K010AT |
| C89-C109 | Чип 0402 X5R - 25 В - 0,1 мкФ ± 10 %, ф. Yageo | 21 | CC0402KRX5R8BB104 |
| C110, C111 | Чип «A» - 10 В - 10 мкФ ± 10 %, ф. KEMET | 2 | T491A106K010AT |
|  |  |  |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| D1 | STM32F103C8T6, ф. STMicroelectronics | 1 |  |
| D2 | KC2016Z16.0000C15XXK, ф. Kyocera AVX | 1 |  |
| D3 | ESD204DQAR, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D4 | SN6501QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D5 | TPS5420DR, ф. Texas instrument | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| D6 | TLV76701DRVT, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D7 | TPS76350QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D8 | ISO1050DUB, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D9 | CP2102-GM, ф. Silicon Laboratories | 1 |  |
| D10-D13 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D14-D17 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D18-D25 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D26-D33 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D34-D41 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D42-D49 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D50-D53 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D54-D57 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D58-D65 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D66-D73 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D74-D81 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D82-D89 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D1 | STM32F103C8T6, ф. STMicroelectronics | 1 |  |
| D2 | KC2016Z16.0000C15XXK, ф. Kyocera AVX | 1 |  |
| D3 | ESD204DQAR, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D4 | SN6501QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D5 | TPS5420DR, ф. Texas instrument | 1 |  |
| D6 | TLV76701DRVT, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D7 | TPS76350QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D8 | ISO1050DUB, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D9 | CP2102-GM, ф. Silicon Laboratories | 1 |  |
| D10-D13 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D14-D17 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D18-D25 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D26-D33 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D34-D41 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| D42-D49 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D50-D53 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D54-D57 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D58-D65 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D66-D73 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D74-D81 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D82-D89 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D1 | STM32F103C8T6, ф. STMicroelectronics | 1 |  |
| D2 | KC2016Z16.0000C15XXK, ф. Kyocera AVX | 1 |  |
| D3 | ESD204DQAR, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D4 | SN6501QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D5 | TPS5420DR, ф. Texas instrument | 1 |  |
| D6 | TLV76701DRVT, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D7 | TPS76350QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D8 | ISO1050DUB, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D9 | CP2102-GM, ф. Silicon Laboratories | 1 |  |
| D10-D13 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D14-D17 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D18-D25 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D26-D33 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D34-D41 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D42-D49 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D50-D53 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D54-D57 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D58-D65 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D66-D73 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D74-D81 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D82-D89 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D1 | STM32F103C8T6, ф. STMicroelectronics | 1 |  |
| D2 | KC2016Z16.0000C15XXK, ф. Kyocera AVX | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| D3 | ESD204DQAR, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D4 | SN6501QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D5 | TPS5420DR, ф. Texas instrument | 1 |  |
| D6 | TLV76701DRVT, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D7 | TPS76350QDBVRQ1, ф. Texas Instrument | 1 |  |
| D8 | ISO1050DUB, ф. Texas Instruments | 1 |  |
| D9 | CP2102-GM, ф. Silicon Laboratories | 1 |  |
| D10-D13 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D14-D17 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D18-D25 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D26-D33 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D34-D41 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D42-D49 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D50-D53 | 74HC595D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D54-D57 | 74HC165D, ф. Nexperia | 4 |  |
| D58-D65 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D66-D73 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D74-D81 | 74HC595D, ф. Nexperia | 8 |  |
| D82-D89 | 74HC165D, ф. Nexperia | 8 |  |
|  |  |  |  |
|  | Индуктивности, ф. Bourns |  |  |
| L1 | SRP7028A-330M | 1 |  |
| L1 | SRP7028A-330M | 1 |  |
| L1 | SRP7028A-330M, ф. Bourns | 1 |  |
| L1 | SRP7028A-330M, ф. Bourns | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  | Резисторы, ф. Yageo |  |  |
| R1-R3 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 % | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R4, R5 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 % | 2 | AA0402JR-070RL |
| R6 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 % | 1 | AA0402FR-0710KL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| R7 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 % | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R8, R9 | Чип 0402 - 6,8 кОм ± 1 % | 2 | RC0402FR-076K8L |
| R10 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 % | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R11, R12 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 % | 2 | AA0402JR-070RL |
| R13-R15 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 % | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R16 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 % | 1 | AA0402JR-070RL |
| R17 | 0402 - 4,7 кОм ± 5 % | 1 | AC0402JR-074K7L |
| R18 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 % | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R19-R22 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 % | 4 | AA0402JR-070RL |
| R23 | Чип 0402 - 120 Ом ± 1 % | 1 | AC0402FR-07120RL |
| R24-R343 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 % | 320 | AA0402FR-0710KL |
| R1-R3 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R4, R5 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 2 | AA0402JR-070RL |
| R6 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R7 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R8, R9 | Чип 0402 - 6,8 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 2 | RC0402FR-076K8L |
| R10 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R11, R12 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 2 | AA0402JR-070RL |
| R13-R15 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R16 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402JR-070RL |
| R17 | 0402 - 4,7 кОм ± 5 %, ф. Yageo | 1 | AC0402JR-074K7L |
| R18 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R19-R22 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 4 | AA0402JR-070RL |
| R23 | Чип 0402 - 120 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AC0402FR-07120RL |
| R24-R343 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 320 | AA0402FR-0710KL |
| R1-R3 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R4, R5 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 2 | AA0402JR-070RL |
| R6 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R7 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R8, R9 | Чип 0402 - 6,8 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 2 | RC0402FR-076K8L |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| R10 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R11, R12 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 2 | AA0402JR-070RL |
| R13-R15 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R16 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402JR-070RL |
| R17 | 0402 - 4,7 кОм ± 5 %, ф. Yageo | 1 | AC0402JR-074K7L |
| R18 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R19-R22 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 4 | AA0402JR-070RL |
| R23 | Чип 0402 - 120 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AC0402FR-07120RL |
| R24-R343 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 320 | AA0402FR-0710KL |
| R1-R3 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R4, R5 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 2 | AA0402JR-070RL |
| R6 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R7 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R8, R9 | Чип 0402 - 6,8 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 2 | RC0402FR-076K8L |
| R10 | Чип 0402 - 2,2 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | RC0402FR-072K2L |
| R11, R12 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 2 | AA0402JR-070RL |
| R13-R15 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 3 | AA0402FR-0710KL |
| R16 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402JR-070RL |
| R17 | 0402 - 4,7 кОм ± 5 %, ф. Yageo | 1 | AC0402JR-074K7L |
| R18 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AA0402FR-0710KL |
| R19-R22 | Чип 0402 - 0 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 4 | AA0402JR-070RL |
| R23 | Чип 0402 - 120 Ом ± 1 %, ф. Yageo | 1 | AC0402FR-07120RL |
| R24-R343 | Чип 0402 - 10 кОм ± 1 %, ф. Yageo | 320 | AA0402FR-0710KL |
|  |  |  |  |
|  | Трансформаторы, ф. Würth Elektronik |  |  |
| T1 | 750313638 | 1 |  |
| T1 | 750313638 | 1 |  |
| T1 | 750313638, ф. Würth Elektronik | 1 |  |
| T1 | 750313638, ф. Würth Elektronik | 1 |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.  обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|  | Диоды |  |  |
| VD1, VD2 | BAT20JFILM, ф. STMicroelectronics | 2 |  |
| VD3, VD4 | MBR0520L, ф. HotTech Semiconductor Technology | 2 |  |
| VD5 | VSSAF5L45, ф.Vishay | 1 |  |
| VD1, VD2 | BAT20JFILM, ф. STMicroelectronics | 2 |  |
| VD3, VD4 | MBR0520L, ф. HotTech Semiconductor Technology | 2 |  |
| VD5 | VSSAF5L45, ф.Vishay | 1 |  |
| VD1, VD2 | BAT20JFILM, ф. STMicroelectronics | 2 |  |
| VD3, VD4 | MBR0520L, ф. HotTech Semiconductor Technology | 2 |  |
| VD5 | VSSAF5L45, ф.Vishay | 1 |  |
| VD1, VD2 | BAT20JFILM, ф. STMicroelectronics | 2 |  |
| VD3, VD4 | MBR0520L, ф. HotTech Semiconductor Technology | 2 |  |
| VD5 | VSSAF5L45, ф.Vishay | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  | Транзисторы, ф. ON Semiconductor |  |  |
| VT1 | NTLJS17D0P03P8Z | 1 |  |
| VT1 | NTLJS17D0P03P8Z | 1 |  |
| VT1 | NTLJS17D0P03P8Z, ф. ON Semiconductor | 1 |  |
| VT1 | NTLJS17D0P03P8Z, ф. ON Semiconductor | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  | Разъемы |  |  |
| XP1 | P-MUSBR-M1C1-M5, ф.Amphenol Corp. | 1 |  |
| XP2, XP3 | BM06B-SRSS-TB, ф. JST | 2 |  |
| XP4 | BM30B-SRDS-A-G-TF, ф. JST | 1 |  |
| XP5 | BM20B-SRDS-G-TF, ф. JST | 1 |  |
| XP6 | 53047-0710, ф. Molex | 1 |  |
| XP7, XP8 | BM30B-SRDS-A-G-TF, ф. JST | 2 |  |
| XP9 | BM20B-SRDS-G-TF, ф. JST | 1 |  |
| XP10 | 53047-0710, ф. Molex | 1 |  |
| XP11 | BM20B-SRDS-G-TF, ф. JST | 1 |  |